

Письма в ЖТФ, том 19, вып. 23

12 декабря 1993 г.

01;05
©1993

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ КВАЗИКРИСТАЛЛОВ

Н.А.Бульченков, В.С.Крапошин

Модульный подход, позволивший обобщить кристаллографию для криволинейных пространств [1–5], целесообразно применить для построения модели икосаэдрического квазикристалла. Центральной проблемой в строении квазикристаллов является противоречие между икосаэдрической симметрией их дифракционных картин и несовместимостью икосаэдрической точечной группы с трансляционной симметрией. Однако в искривленных пространствах с локальной икосаэдрической симметрией возможна трансляция в одном направлении [6], позволяющая образовать из икосаэдрических атомных кластеров стержни [2–6].

На рис. 1,*a–e* показаны атомные кластеры, участвующие в образовании кристаллических структур некоторых интерметаллидов алюминия [7]. На рис. 1,*a* показан икосаэдрический координационный полиэдр, объединение таких полиэдров по принципу “система–систем” будем называть модулем *n*-го иерархического уровня. Объединение трех или четырех координационных полиэдров образует модули 1-го иерархического уровня: с осью симметрии 3-го порядка (модуль D_{3h} , рис. 1,*b*) и тетраэдрической симметрией (модуль T_d , рис. 1,*c*). Кластеры D_{3h} и T_d являются частью четырехмерного икосаэдра, описываемого в виде политопа {335} [6]. Политоп — обобщение ряда полигон, полиэдр...

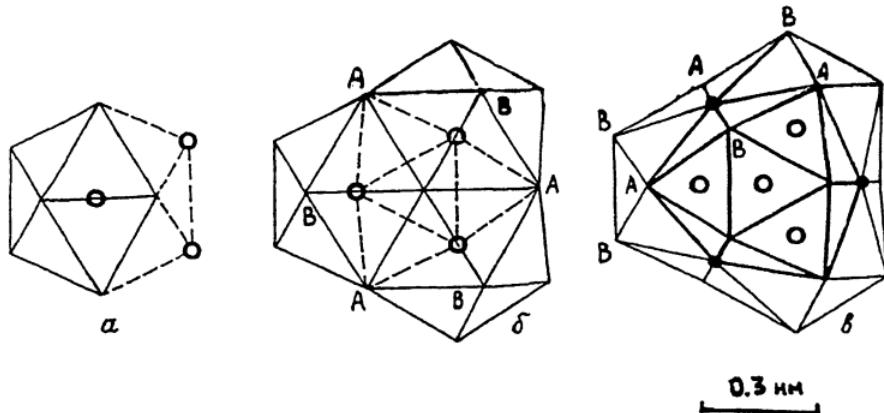


Рис. 1. Образование модулей I иерархического уровня из атомного икосаэдрического координационного полиэдра.

a — икосаэдрический атомный полигон. Светлыми кружочками показаны позиции атомов, оказавшихся в центре икосаэдров после их объединения. Пунктиром показаны ребра, которые становятся невидимыми в данной проекции после объединения икосаэдров;

b — иерархический модуль D_{3h} , образованный объединением трех икосаэдрических полигонов, один из которых показан на рис. 1, *a*. Атомы, центрирующие ребра двух соседних икосаэдров, образуют ребро третьего икосаэдра. Пунктиром показаны ребра индивидуальных икосаэдров (*a*), ставших невидимыми после объединения. Ось симметрии третьего порядка всего модуля перпендикулярна плоскости рисунка. Последовательность узлов $ABA\dots$ образует гексацикл. В узлах типа *A* сходятся по 6, а в узлах типа *B* по 5 атомных связей соответственно. Модуль D_{3h} является элементом кристаллической структуры соединений Al_5Co_2 , $Al_{10}Mn_3$ и $Al_{23}V_4$ [7], атомы переходного металла занимают позиции, обозначенные светлыми кружками, остальные вершины заняты атомами алюминия;

c — иерархический модуль T_d с тетраэдрической симметрией, образованный добавлением четвертого икосаэдрического полигона к модулю D_{3h} , ребра добавленного икосаэдра показаны утолщенными линиями. Вершины одного из гексациклов обозначены буквами *A* и *B*, как на рис. 1, *b*. Модуль T_d является элементом кристаллической структуры соединения $Al_{13}Si_4Cr_4$ [7], позиции атомов кремния в центре гексациклов обозначены темными кружками, позиции атомов хрома светлыми кружками. Остальные вершины заняты атомами алюминия.

на пространства с размерностью более трех. Оба кластера могут быть объединены по гексациклам практически без деформации атомных связей так что образуется стержень в последовательности $T_d - D_{3h} - T_d$ (рис. 2). В такой последовательности угол разворота тетраэдра при трансляции вдоль стержней равен нулю, что является условием перекладки (стыковки) направленных тетраэдрических связей в структурах [3].

Повторяя операцию объединения модулей в этой последовательности, получим полый иерархический модуль кластриального типа в виде пентагонодекаэдра с икосаэдрической симметрией всего модуля. На рис. 3 этот модуль показан в направлении оси симметрии 5-го порядка. Это модуль второго иерархического уровня. Длина ребра пентагонодекаэдра a_5 составляет 0.75–0.85 нм в зависимости от атомного радиуса переходного металла.

Эти иерархические модули можно сочленять по пентагональным граням. В таком случае вдоль каждого ребра пентагонодекаэдра

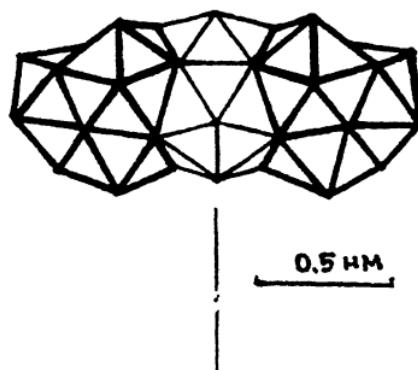


Рис. 2. Стержень, образованный объединением иерархических модулей T_d и T_{3h} по гексациклам в последовательности $T_d - D_{3h} - T_d$. При объединении позиции типа *A* одного модуля совпадают с позициями типа *B* соседнего модуля. Пунктиром показан след плоскости зеркальной симметрии, перпендикулярной оси стержня. Жирными линиями показаны ребра T_d -модулей.

тагондодэкаэдра будут соседствовать три модуля II уровня. Двугранный угол пентагондодэкаэдра составляет только 116.57° , поэтому необходимо скомпенсировать возникающие клиновые зазоры величиной $360^\circ - 3 \cdot 116.57^\circ = 10.29^\circ$. Зазоры можно устраниТЬ введением другого полиэдра — гексакадэкаэдра (шестнадцатигранника), производного от пентагондодэкаэдра. И пентагондодэкаэдр, и гексакадэка-

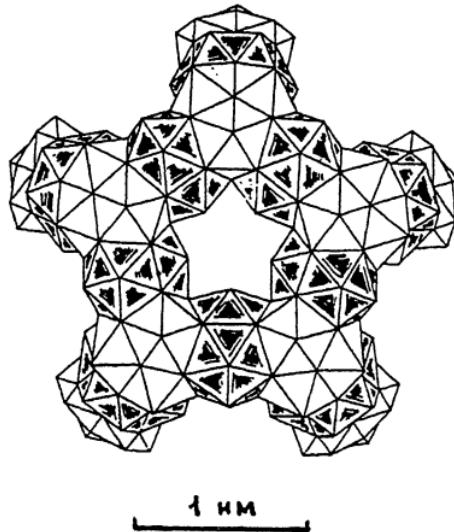
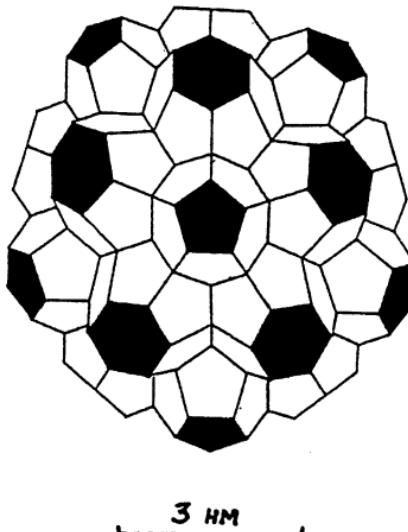


Рис. 3. Клатратный модуль II иерархического уровня в виде пентагондодэкаэдра. Ось симметрии 5-го порядка перпендикулярна плоскости рисунка. D_{3h} -модули выделены штриховкой.



3 нм

Рис. 4. Сферический модуль III иерархического уровня с икосаэдрической симметрией целого. Ось 5-го порядка перпендикулярна плоскости рисунка. Вокруг центрального пентагонододекаэдра располагаются пять гексакадекаэдров.

Эдры являются координационными полиэдрами в кристаллических структурах газогидратов II типа [8].

Последовательно присоединяя эти клатратные модули, получим кластер III иерархического уровня в виде сферы с икосаэдрической симметрией целого. На рис. 4 этот модуль показан в направлении оси 5-го порядка. Он содержит 25 пентагонододекаэдров и 20 гексакадекаэдров. Все 20 гексакадекаэдров располагаются во втором слое (считая от центрального модуля-пентагонододекаэдра) и вместе с 12 пентагонододекаэдрами образуют оболочку типа молекулы фуллерена C_{60} , гексациклам которой соответствуют гексакадекаэдры, а пентациклам — пентагонододекаэдры. Все пентагонододекаэдры во втором слое находятся в параллельном положении и принадлежат непрерывным цепочкам этих полиэдров, ориентированных по 12 направлениям пучка шести осей пятого порядка сферического икосаэдрического модуля. Диаметр сферы $D = 4d_0$, где d_0 — диаметр сферы, вписанной в пентагонододекаэдр, $d_0 = 2.227a_5$, поэтому численное значение D составляет примерно 6.6 нм. Одновременно центры пентагонододекаэдров второго слоя образуют икосаэдр с ребром $a_3 = \frac{2d_0}{\cos 18^\circ} \approx 3.5$ нм.

Химический состав сферы соответствует формуле $Al_{77.6}Mn_{22.4}$ для двойного сплава или $Al_{67.5}Si_{10.1}Mn_{22.4}$ для тройного сплава, что хорошо согласуется с экспериментом [9,10].

Поскольку эти сферические модули эквивалентны икосаэдру, из них можно образовать модули четвертого иерархи-

ческого уровня при взаимопроникновении трех или четырех сфер, т.е. по алгоритму, показанному на рис. 1. На этом этапе индивидуальные атомы в модулях I иерархического уровня заменяются на сферические модули III иерархического уровня. Затем можно было бы повторить описанные выше операции образования стержней (рис. 2) и следующих иерархических модулей (рис. 3), однако таким образом пространство заполнить не удается из-за увеличивающихся напряжений.

Это затруднение можно устранить заменой последовательности модулей четвертого иерархического уровня $T_d - D_{3h} - T_d$ на последовательность $T_d - T_d - T_d$. Из 5 модулей четвертого уровня типа T_d складывается усеченный тетраэдр, а из 10 — усеченный октаэдр. Октаэдрами и тетраэдрами можно заполнить кристаллическое пространство с кубической решеткой. Поскольку ребро построенного из сфер тетраэдра составляет $(3/2)D$, то период куба составит $(3\sqrt{2}/2)D \approx 14$ нм. В кубической решетке ребром тетраэдра соответствуют 12 направлений $\langle 110 \rangle$ с углом 60° между ними. В нашем случае ребра тетраэдра образованы цепочками пентагонододекаэдров, сочлененных по граням, т.е. параллельны осям 5-го порядка с углами между ними 63.43° . Гомологическим преобразованием кубической симметрии в тетрагональную с отношением осей $\frac{c}{a} \approx 0.95$ можно у 8 из 12 осей $\langle 110 \rangle$ изменить угол от 60 до 63.43° .

Поскольку в эксперименте наблюдался габитус квазикристаллов в виде триаконтаэдра [11], то при индицировании имеющихся в литературе дифракционных картин наиболее сильные отражения будут иметь индексы $\{h00\}$, $\{\tau^2\tau 1\}$ и $\{\tau 01\}$, где $\tau = (1 + \sqrt{5})/2$ — золотое число, приближенно выражаемое отношением соседних членов ряда Фибоначчи (например, $8/5$, $13/8$, $21/13$ и т.д.). Индексам $\{h00\}$ и $\{\tau^2\tau 1\}$ соответствуют грани триаконтаэдра, являющиеся комбинацией граней куба $\{h00\}$ и дидодекаэдра $\{hkl\}$ в кубической установке. Ребром с индексами $\{\tau 01\}$, параллельным всем шести осям 5-го порядка, соответствуют цепочки сочлененных по граням пентагонододекаэдрических модулей II иерархического уровня, являющихся цепочками сильной связи в теории структурной морфологии [12] и обусловливающие триаконтаэдрический габитус квазикристалла.

На основе этой модели нам удалось проиндицировать даже те рефлексы, индексы которых не были установлены в [13] в рамках модели пятикратно двойникованной кубической структуры. По результатам нашего индицирования квазикристалл состава $Al_{86}Mn_{14}$ имеет периоды тетрагональной решетки $c = 3.15$, $a = 3.32$ нм, $\frac{c}{a} = 0.95$ (по рентгено-

нограмме в работах [14,15]); квазикристалл состава $\text{Al}_{78}\text{Mn}_{22}$ имеет периоды $c = 3.41$, $a = 3.31$ нм, (по рентгенограмме в работе [15]). Квазикристалл состава Pd_3USi имеет периоды решетки $c = 3.63$, $a = 3.72$ нм, $\frac{c}{a} = 0.97$ (по рентгенограмме в работе [16]). Вычисленные нами периоды квазикристаллических фаз составляют примерно половину диаметра сферического модуля III иерархического уровня (рис. 4). Максимальное межплоскостное расстояние 2.21 нм зафиксировано на рентгенограмме квазикристалла Pd_3USi [16], в нашей модели это отражение с индексами (111). У квазикристалла состава $\text{Al}_{78}\text{Mn}_{22}$ на рентгенограмме зафиксировано отражение, соответствующее межплоскостному расстоянию 1.388 нм, в нашей модели это отражение (112).

Геометрические особенности нашей модели согласуются и с данными просвечивающей электронной микроскопии. Например, сообщается о наблюдении на изображениях периодичности в 3.2, 5.1 и 9.8 нм [17]. На изображениях квазикристаллов также наблюдаются десятичленные кольца (“колеса”) диаметром 1.3 и 1.8 нм [17]. Диагональ пентагональной грани модуля на рис. 3 равна $\tau a_5 \approx 1.3$ нм, а диаметр вписанной сферы $d_0 \approx 1.8$ нм.

Иерархическая сборка квазикристаллов из кластеров, существование которых в расплаве весьма вероятно, позволяет объяснить не только дифракционные и микроскопические данные, но также понять, почему при закалке расплавов квазикристалл выигрывает конкуренцию в росте с обычным кристаллом. Модульная сборка обеспечивает бездефектную сборку в условиях экстремальных скоростей охлаждения, а высокое совершенство точечных электронограмм указывает на высокое совершенство структуры квазикристаллов. Представленная модель показывает также, что образование квазикристаллов в чистых металлах невозможно.

Список литературы

- [1] Бульченко Н.А. // ДАН СССР. 1985. Т. 284. В. 6. С. 1392–1396.
- [2] Бульченко Н.А. // Кристаллография. 1988. Т. 33. В. 2. С. 424–444.
- [3] Бульченко Н.А. // Кристаллография. 1990. Т. 35. В. 1. С. 147–154.
- [4] Бульченко Н.А. // Там же, с. 155–163.
- [5] Бульченко Н.А. // Биофизика. 1991. Т. 36. В. 2. С. 181–243.
- [6] Sadoc J.F., Mosseri R. / In: Extended Icosahedral Structures / Ed. by Jarić M.V., Gratias D. Acad. Press. Inc. (Ldn). Ltd. 1989. P. 163–188.
- [7] Шуберт К. Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз. Берлин, 1964, Пер. с нем. М.: Металлургия, 1971. 536 с.
- [8] Pauling L., Marsh R. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1952. V. 38. P. 112.
- [9] Schaefer R.J., Bendersky L.A., Shechtman D., Boettinger W.J., Biancanello F.S. // Met. Trans. A. 1986. V. 17A. P. 2117–2125.
- [10] Chen C.H., Chen H.S. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33. N 4. P. 2814–2816.

- [11] Ranganathan S., Chattopadhyay K. // Annu. Rev. Mater. Sci. 1991. V. 21. P. 437–462.
- [12] Hartman P., Perdok W.G. // Acta Cryst. 1955. V. 8. P. 49–52; 521–524; 525–529.
- [13] Pauling L. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1988. V. 85. P. 4587–4590.
- [14] Bancel P.A. et al. // Phys. Rev. Letters. 1985. V. 54. N 22. P. 2422–2425.
- [15] Rajasekharan T., Sekhar J.A. // Ser. Met. 1986. V. 20. N 1. P. 235–238.
- [16] Kofalt D.D., Nanao S., Egami T., Wong K.M., Poon S.J. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 57. P. 114–117.
- [17] Audier M., Robertson B. // Phil. Mag. Lett. 1991. V. 64. N 6. P. 401–409.

Институт проблем
технологии микроэлектроники
и особычистых материалов
Черноголовка

Поступило в Редакцию
5 сентября 1993 г.
